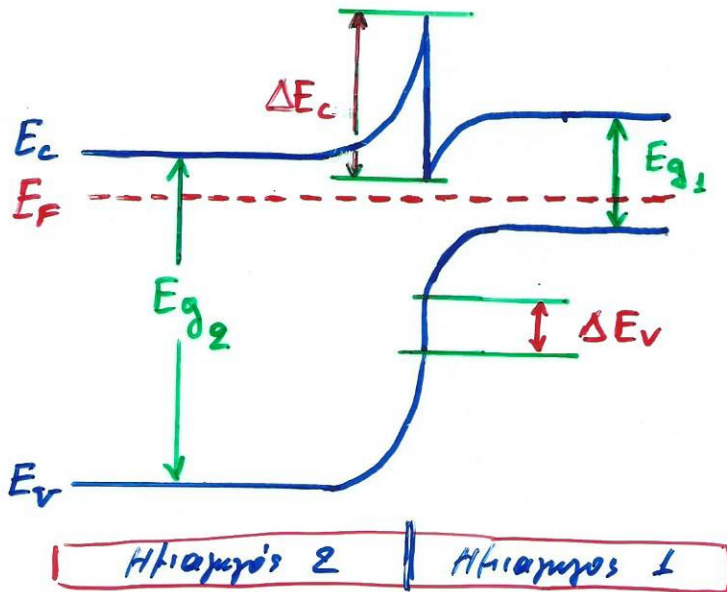


## ΕΤΕΡΟΕΠΑΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

Το κύριο ερώτημα είναι πόσες θα είναι οι ασυνέχειες  $\Delta E_c$ ,  $\Delta E_v$ .



$$\Delta E_v + \Delta E_c = E_{g2} - E_{g1}$$

### Απλοϊκά Μοντέλα

1. Electron affinity rule (ή μοντέλο Anderson):  $\Delta E_c = (\chi_1 - \chi_2)q$
2. Γομωση αήθση rule:  $\Delta E_v \approx 0$  για ίδιο ανιόν ( $\text{III-V}$ )
3. "Effective work function model" για χημικοί αντιδρώτες διεπιφάνειες (interfaces):  $\Phi_{eff}$  από ανάμιξη  $\Phi$  διαφόρων φάσεων

### Γενικές Θεωρίες

1. Η θεωρία των Freunley and Kroemer (1977) και του W. Harrison (1977). Προσδιορίζουν την  $\Delta E_v$  αφού πρώτα υπολογίσουν την θέση της ενεργειακής δομής των ζωνών και τη μηχανογού ως προς καθορισμένη κλίμακα ενέργειας.

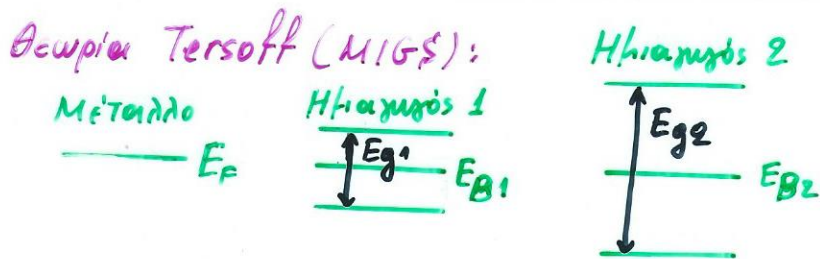
2. θεωρίες βασισμένες σε μεταλ-induced (ή semiconductor-induced) gap states (MIGS), και σε ορθικές ηθετρικis ουδετηρότητας.

Heine: Οι κυματοσυναρτίσεις τη Me εισέρχονται στο χάσμα του ηλιαγωγού και δημιουργούν τοπικές καταστάσεις.

Tersoff: Στο "midgap energy point" αλλάζουν χαρακτήρα από καταστάσεις τύπου αγωγιότητας σε ορίους. Στην ετηροεπαφή οι ετισώνονται τα δύο midgap points. Το ίδιο για Schottky.

Οι Cardona και Christensen έχουν κάτι αντίστοιχο, το DME: "Dielectric Midgap Energy".

3. Υπολογίζεται απ' ευθείας η ηλεκτρονική δομή της ετηροεπαφής. Ρεαλιστικοί υπολογισμοί είναι πολύ περιηλοκοί, με τεχνικές όπως: self-consistent pseudopotential calculation, self-consistent density-functional calculations με ab initio non-local pseudopotentials



Επαφή Schottky:  $\Phi_B = E_g - E_B$

Ητεροεπαφή 1-2:  $\Delta E_V = E_{V1} - E_{V2}$

Αν κάνουμε επαφές δύο επαφής Schottky σε διαφορετικούς ηλιαγωγούς και βρούμε τα  $\Phi_{B1}$ ,  $\Phi_{B2}$ , τότε η ετηροεπαφή τους πρέπει να δώσει

$$\Delta E_V = \Phi_{B1} - \Phi_{B2} + (E_{g2} - E_{g1})$$

# ΕΤΕΡΟΣΕΠΑΦΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΟ ANDERSON

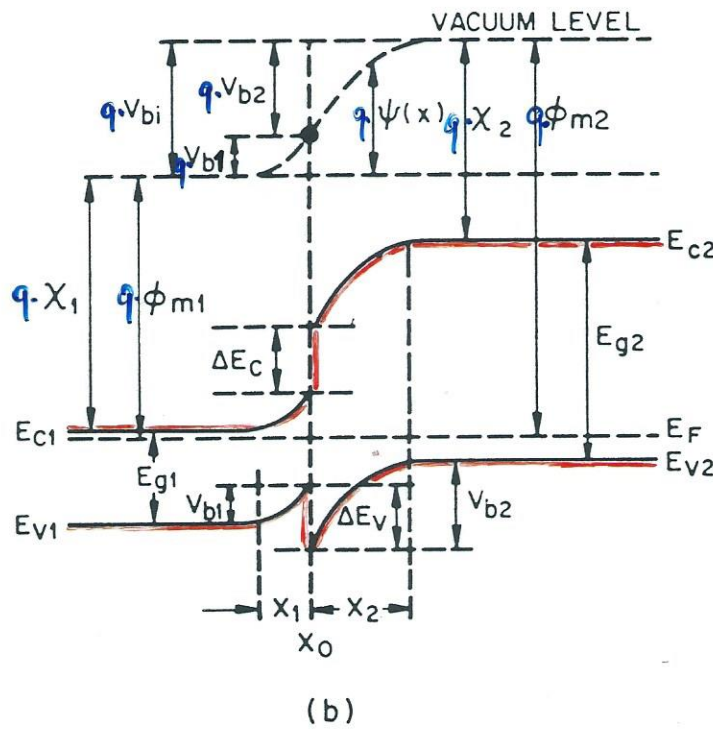
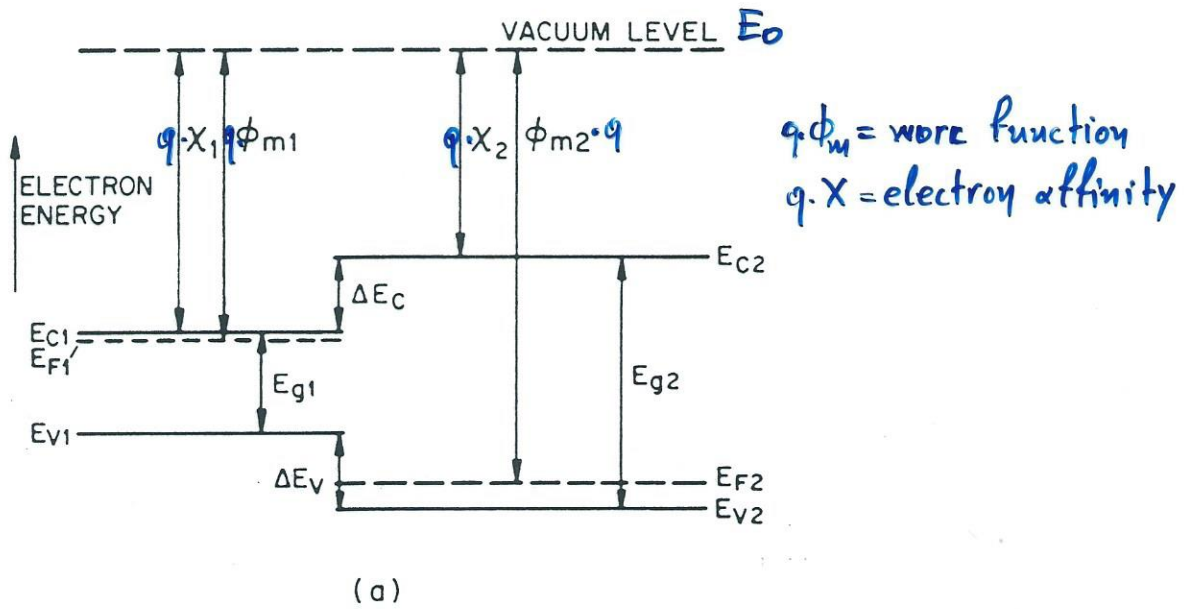


Fig. 44 (a) Energy-band diagram for two isolated semiconductors in which space-charge neutrality is assumed to exist in each region. (b) Energy-band diagram of an ideal n-p anisotype heterojunction at thermal equilibrium. (After Anderson, Ref. 60.)

ΜΟΝΤΕΛΟ ANDERSON:  $\Delta E_c = q(\chi_1 - \chi_2)$  ① ELECTRON AFFINITY RULE

$V_{bi} = V_{b1} + V_{b2}$  ②

$\Delta E_v + \Delta E_c = E_{G2} - E_{G1}$  ③

Isotype heterojunction: ίδιου τύπου n-n ή p-p

Anisotype heterojunction: διαφορετικού τύπου np ή p-n

## ΜΟΝΤΕΛΟ ANDERSON ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ η-Ρ

Αναφέρεται και σαν "electron affinity rule"

Έχει αποδειχθεί ανεπαρκές για την περιγραφή διαφόρων ετεροηαφών, αλλά υπήρξε το πρώτο εργαλείο για ανάπτυξη της έρευνας των ετεροηαφών. Εισαίγει τις διάφορες ποσότητες που χαρακτηρίζουν των ενδοηαφαια και είναι ικανοποιητικό σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ο Anderson έχει περιγράψει γενικά όλα τα χαρακτηριστικά μιας ετεροηαφής κι η περιγραφή αυτή ισχύει εστω κι αν οι τιμές των  $\Delta E_c$  και  $\Delta E_v$  δεν δίνονται από τον "electron affinity rule".

Το μοντέλο "electron affinity rule" έχει στηριχθεί θεωρητικά από τους Mailhot and Duke (1986) που κατέληξαν (για p-n ετεροηαφή χωρίς σταθιακές αλλαγές ότι

$$\Delta E_c = \chi_1 - \chi_2 + V_{\text{dipole}}$$

Ο όρος  $V_{\text{dipole}} \sim 100 \text{ meV}$  και επομένως δεν αειρώνεται το E.A.R.

Το E.A.R. αγνοεί μικροσκοπικές αλλαγές που μπορεί να συμβούν στην ετεροηαφή. Λαμβάνει, όμως, εν μέρη υπό όψη το σχηματισμό ενδοηαφής αφού οι  $\chi$  μετρώνται μεταξύ ημιαγωγού και κενού και επηρεάζονται από φαινόμενα της επιφάνειας. Δηλαδή, το E.A.R. προσομοιώνει τα μικροσκοπικά φαινόμενα της επαφής με γραμμικό συνδυασμό παρόμοιων φαινομένων, που ελέγχουν τις "δενηαφής" ημιαγωγού-κενού.

Επιλύοντας την εφ. Poisson σε κάθε ημιερμεί της ετεροεπαφής n-p (απότομη επαφή) και με οριακή συνθήκη την συνέχεια της ηλεκτρικής μετατόπισης, D,

$$\epsilon_1 \epsilon_1 = \epsilon_2 \epsilon_2 \quad (4)$$

παίρνουμε

$$x_1 = \left[ \frac{2 N_{A2} \epsilon_1 \epsilon_2 (V_{bi} - V)}{q N_{D1} (\epsilon_1 N_{D1} + \epsilon_2 N_{A2})} \right]^{1/2} \quad (5)$$

$$x_2 = \left[ \frac{2 N_{D1} \epsilon_1 \epsilon_2 (V_{bi} - V)}{q N_{A2} (\epsilon_1 N_{D1} + \epsilon_2 N_{A2})} \right]^{1/2} \quad (6)$$

$$C = \left[ \frac{q N_{D1} \cdot N_{A2} \cdot \epsilon_1 \cdot \epsilon_2}{2 (\epsilon_1 N_{D1} + \epsilon_2 N_{A2}) (V_{bi} - V)} \right]^{1/2} \quad (7)$$

όπου  $W = x_1 + x_2 \quad (8)$

Η τάση <sup>πώλησης</sup> που "πέφτει" σε κάθε ημιερμεί της ετεροεπαφής είναι

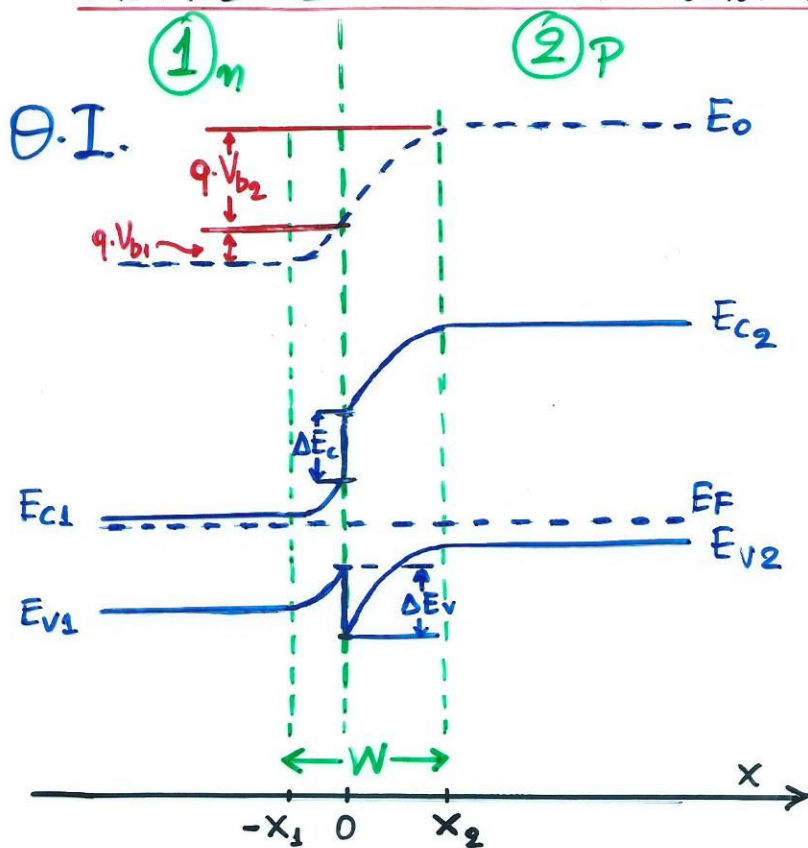
$$\frac{V_{b1} - V_1}{V_{b2} - V_2} = \frac{N_{A2} \cdot \epsilon_2}{N_{D1} \cdot \epsilon_1} \quad (9)$$

όπου  $V = V_1 + V_2 \quad (10)$

\* ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

\* από τις ανωτέρω σχέσεις παίρνουμε τις σχέσεις για μια <sup>ομο-</sup>επαφή pn βύθοντας  $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_s = \kappa_s \epsilon_0$  (ίδιος ημιαγωγός)

# ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Π.Α.



Π.Α.: Περιοχή Αποχύμωσης  
από ελεύθερους φορείς  
ηλεκτρονίων  $n$

## ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ (υπόθεση πλήρους ιονισμού προσκίσεων)

$$\rho(x) = q(p-n + N_D - N_A) \quad \rightarrow \quad \rho_1(x) = q \cdot N_{D1} \quad \text{①} \quad \text{πλευρά -1 της Π.Α.}$$

$$\rho_2(x) = -q \cdot N_{A2} \quad \text{②} \quad \text{πλευρά -2 της Π.Α.}$$

(φορτίο/cm<sup>3</sup>)

Εξίσωση Poisson στην κατεύθυνση-x:  $\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{dE}{dx} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon} \quad \text{③}$

Περιοχή 1 (n):  $\frac{dE}{dx} = \frac{q \cdot N_{D1}}{\epsilon_1} \quad \text{④} \quad \text{για} \quad -x_1 \leq x < 0$

$$\int_{E(-x_1)}^{E(x)} dE = \int_{-x_1}^x \frac{q \cdot N_{D1}}{\epsilon_1} dx = \frac{q \cdot N_{D1}}{\epsilon_1} (x + x_1) \quad \text{⑤} \quad \Rightarrow \quad \boxed{E(x) = \frac{q \cdot N_{D1}}{\epsilon_1} (x + x_1)} \quad \text{⑥}$$

για  $-x_1 \leq x < 0$

Στα όρια  $-x_1$  και  $x_2$  της Π.Α είναι  $E = 0$

$$\Rightarrow E(-x_1) = E(x_2) = 0 \quad \text{⑤}$$

Περιοχή 2 (P):  $\frac{dE}{dx} = \frac{-q \cdot N_{A2}}{\epsilon_2}$  (7) για  $0 < x \leq x_2$

$\int_{E(x)}^{E(x_2)} dE = \int_x^{x_2} \frac{-q \cdot N_{A2}}{\epsilon_2} dx = -\frac{q \cdot N_{A2}}{\epsilon_2} (x_2 - x)$  (8) για  $0 < x \leq x_2$

(8)  $\xrightarrow{(5)}$   $E(x) = \frac{q \cdot N_{A2}}{\epsilon_2} (x_2 - x)$   
για  $0 < x \leq x_2$  (9)

Η συνέχεια της ηλεκτρικής μετατόπισης,  $D$ , στην ετερογενή των δύο υλικών απαιτεί  $D_1 \cdot \hat{n} = D_2 \cdot \hat{n}$  (ή κείθετο στην επαφή).

$\Rightarrow \epsilon_1 \cdot E_1 = \epsilon_2 \cdot E_2$  (10) στο  $x=0$ .

(10)  $\xrightarrow{(6)(9)}$   $\epsilon_1 \cdot \frac{q N_{D1}}{\epsilon_1} x_1 = \epsilon_2 \cdot \frac{q \cdot N_{A2}}{\epsilon_2} x_2 \Rightarrow \frac{N_{D1}}{N_{A2}} = \frac{x_2}{x_1}$  (11)

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΣ ΑΛΛΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΗΝ Π.Α. ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ

Είναι, επίσης,  $W = x_1 + x_2$  (12)

και επομένως  $x_1 = \frac{N_{A2}}{N_{A2} + N_{D1}} \cdot W$  (13) και  $x_2 = \frac{N_{D1}}{N_{A2} + N_{D1}} \cdot W$  (14)

Υπολογισμός των ηλεκτρικών δυναμικών  $V(x)$ :

Ορίζουμε

$V_{b1}$  την διαφορά δυναμικού που πέφτει στην πλευρά-1 της Π.Α. ( $V(-x_1) - V(0)$ )

$V_{b2}$  " " " " " " " " την πλευρά-2 της Π.Α. ( $V(0) - V(x_2)$ )

(15)  $V_b = V_{b1} + V_{b2}$  την διαφορά δυναμικού στις άκρες της Π.Α. ( $V(-x_1) - V(x_2)$ )

θεωρούμε ότι  $V(-x_1) = V_b$  (16) εκ συνθήκων και έχουμε

$$E = -\frac{dV}{dx} \Rightarrow \frac{dV}{dx} = \frac{-q \cdot N_{D1}}{\epsilon_1} (x + x_1) \text{ (17) για } -x_1 \leq x < 0$$

$$\Rightarrow \int_{V(-x_1)}^{V(x)} dV = \frac{-q \cdot N_{D1}}{\epsilon_1} \int_{-x_1}^x (x + x_1) dx = \frac{-q \cdot N_{D1}}{\epsilon_1} \frac{(x + x_1)^2}{2}$$

$$\Rightarrow V(x) = V_b - \frac{q \cdot N_{D1}}{\epsilon_1} \frac{(x + x_1)^2}{2} \text{ για } -x_1 \leq x < 0 \text{ (18)}$$

Επειδή εξ' ορισμού  $V(-x_1) - V(0) = V_{b1}$  (16/18)

$$V_{b1} = \frac{q \cdot N_{D1}}{\epsilon_1} \frac{x_1^2}{2} \text{ (19)}$$

Στην ηλεκτρονική ζώνη είναι  $\frac{dV}{dx} = \frac{-q \cdot N_{A2}}{\epsilon_2} (x_2 - x)$  (9)

$$\Rightarrow \int_{V(x)}^{V(x_2)} dV = \frac{-q \cdot N_{A2}}{\epsilon_2} \int_x^{x_2} (x_2 - x) dx \Rightarrow V(x_2) - V(x) = \frac{-q \cdot N_{A2}}{\epsilon_2} \frac{(x_2 - x)^2}{2} \text{ (20)}$$

για  $0 < x \leq x_2$

Επειδή, εξ' ορισμού  $V(0) - V(x_2) = V_{b2} \Rightarrow$

$$V_{b2} = \frac{q \cdot N_{A2}}{\epsilon_2} \frac{x_2^2}{2} \text{ (21)}$$

Εξ' ορισμού είναι και  $V_b = V(-x_1) - V(x_2) \text{ (16)} = V_b - V(x_2) \Rightarrow V(x_2) = 0 \text{ (22)}$

$$\text{(20) } \Rightarrow V(x) = \frac{q \cdot N_{A2}}{\epsilon_2} \frac{(x_2 - x)^2}{2} \text{ (23)}$$

για  $0 < x \leq x_2$



Η συνέχεια στο  $x=0$  (η, ότι  $V_b = V_{b1} + V_{b2}$ ) απαιτεί

$$(18) + (23) \Rightarrow \boxed{V_b - \frac{q \cdot N_{D1}}{\epsilon_1} \frac{x_1^2}{2} = \frac{q \cdot N_{A2}}{\epsilon_2} \frac{x_2^2}{2}} \quad (24)$$

Αντικαθιστώντας τα  $x_1, x_2$  συναρτήσεις των  $W$ , σύμφωνα με τις (14), (13)  $\Rightarrow$

$$(24) \Rightarrow V_b - \frac{q \cdot N_{D1}}{2\epsilon_1} \cdot \frac{N_{A2}^2}{(N_{A2} + N_{D1})^2} W^2 = \frac{q \cdot N_{A2}}{2\epsilon_2} \cdot \frac{N_{D1}^2}{(N_{A2} + N_{D1})^2} W^2$$

$$\Rightarrow V_b = W^2 \cdot \frac{q}{2} \cdot \frac{N_{D1} \cdot N_{A2} (\epsilon_2 \cdot N_{A2} + \epsilon_1 \cdot N_{D1})}{\epsilon_1 \cdot \epsilon_2 (N_{A2} + N_{D1})^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{W = \left[ \frac{2 \epsilon_1 \cdot \epsilon_2 \cdot V_b}{q} \cdot \frac{(N_{A2} + N_{D1})^2}{N_{D1} \cdot N_{A2} (\epsilon_2 \cdot N_{A2} + \epsilon_1 \cdot N_{D1})} \right]^{1/2}} \quad (25)$$

$$\boxed{W = \left[ \frac{2 \epsilon_1 \cdot \epsilon_2 \cdot V_b}{q} \cdot \frac{(N_{A2} + N_{D1})^2}{N_{D1} \cdot N_{A2} (\epsilon_2 \cdot N_{A2} + \epsilon_1 \cdot N_{D1})} \right]^{1/2}} \quad (26)$$

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις (13), (14) και των (26) έχουμε

$$x_1 = \left[ \frac{2 N_{A2} \cdot \epsilon_1 \cdot \epsilon_2 \cdot V_b}{q N_{D1} \cdot (\epsilon_1 N_{D1} + \epsilon_2 \cdot N_{A2})} \right]^{1/2} \quad (27)$$

$$x_2 = \left[ \frac{2 N_{D1} \cdot \epsilon_1 \cdot \epsilon_2 \cdot V_b}{q N_{A2} \cdot (\epsilon_1 N_{D1} + \epsilon_2 \cdot N_{A2})} \right]^{1/2} \quad (28)$$

Για το ποσοστό των εσωτερικών δυναμικού  $V_b$  της επαφής που πέφτει σε κάθε ηλεκτρόνιο έχουμε τον λόγο

$$(19), (21) \Rightarrow \frac{V_{b1}}{V_{b2}} = \frac{\frac{q \cdot N_{D1} \cdot x_1^2}{2 \epsilon_1 \epsilon_0}}{\frac{q \cdot N_{A2} \cdot x_2^2}{2 \epsilon_2 \epsilon_0}} = \frac{\epsilon_2 \cdot N_{D1}}{\epsilon_1 \cdot N_{A2}} \cdot \frac{x_1^2}{x_2^2}$$

$$(11) \Rightarrow \frac{V_{b1}}{V_{b2}} = \frac{\epsilon_2 \cdot N_{D1}}{\epsilon_1 \cdot N_{A2}} \cdot \frac{N_{A2}^2}{N_{D1}^2} \Rightarrow \boxed{\frac{V_{b1}}{V_{b2}} = \frac{\epsilon_2 \cdot N_{A2}}{\epsilon_1 \cdot N_{D1}}} \quad (29)$$

Αν εφαρμόσουμε εξωτερική τάση πρόωσης  $V$  στην  $n-p$  επαφή τα  $W, x_1, x_2$  θα δίνονται από τις ίδιες σχέσεις (26), (27), (28), αντίστοιχα, αντικαθιστώντας όπου  $V_b$  το  $V_b - V$ .

Για εξωτερική τάση πρόωσης  $V$  θα πέσει τάση  $V_1$  στην ηλεκτρόνιο-1 και  $V_2$  στην ηλεκτρόνιο-2. Ο λόγος της διαφοράς δυναμικού που αναπτύσσεται σε κάθε ηλεκτρόνιο θα δίνεται τότε από την (29) αντικαθιστώντας το  $V_{b1}$  με  $V_{b1} - V_1$  και το  $V_{b2}$  με  $V_{b2} - V_2$ .

Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Π.Α.:

$C = \frac{dQ}{dV}$  ανά μονάδα επιφάνειας, όπου  $dQ$  η στοιχειώδης μεταβολή του φορτίου ανά μονάδα επιφάνειας για στοιχειώδη μεταβολή  $dV$  της τάσης

$$|Q(V)| = q \cdot N_{A2} \cdot x_2 = q \cdot N_{D1} \cdot x_1 \quad (30) \text{ ανά μονάδα επιφάνειας}$$

$$G(V) = \left| \frac{dQ}{dV} \right| = \frac{d(q \cdot N_{D1} \cdot x_1)}{dV} = q \cdot N_{D1} \cdot \left| \frac{dx_1}{dV} \right| \quad (31)$$

$$(27) \Rightarrow \left| \frac{dx_1}{dV} \right| = \left[ \frac{2 N_{A2} \cdot \epsilon_1 \cdot \epsilon_2}{q \cdot N_{D1} (\epsilon_1 N_{D1} + \epsilon_2 N_{A2})} \right]^{1/2} \cdot \frac{1}{2} (V_b - V)^{-1/2}$$

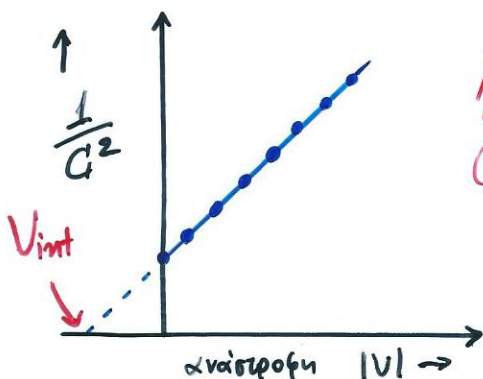
$$\Rightarrow G(V) = \left[ \frac{q \cdot N_{D1} \cdot N_{A2} \cdot \epsilon_1 \cdot \epsilon_2}{2 (V_b - V) (\epsilon_1 N_{D1} + \epsilon_2 N_{A2})} \right]^{1/2} \quad (32)$$

Τέλος, μια πιο ακριβή λύση που λαμβάνει υπ' όψη ότι η Π.Α. δεν είναι απήρονη αλλά υπάρχουν δύο "ουρές" κατανομής των φορέων πλεονότητας στα όρια της Π.Α. δίνει σαν διόρθωση τον όρο  $(V_b - 2kT/q)$  αντί του  $V_b$  για τα πλάτη της Π.Α. και την  $G(V)$ .

(δείτε ΣΣΕ, επαφή PN)

Μια πιο χρήσιμη μορφή της σχέσης  $G(V)$  προκύπτει εκφράζοντας το  $G^{-2}$  συναρτήσει του  $V$ . Είναι

$$\frac{1}{G^2(V)} = \frac{2 (\epsilon_1 N_{D1} + \epsilon_2 N_{A2})}{q \cdot \epsilon_1 \cdot \epsilon_2 \cdot N_{D1} \cdot N_{A2}} \left( V_b - \frac{2kT}{q} - V \right)$$



Γραφική παράσταση πειραματικών μετρήσεων  $1/G^2 - V$  (ανήστροφη  $V$ ) και προέκτασή της καθόληως σε

$$1/G^2 = 0 \text{ δίνει } V_{int} = V_b - \frac{2kT}{q}$$

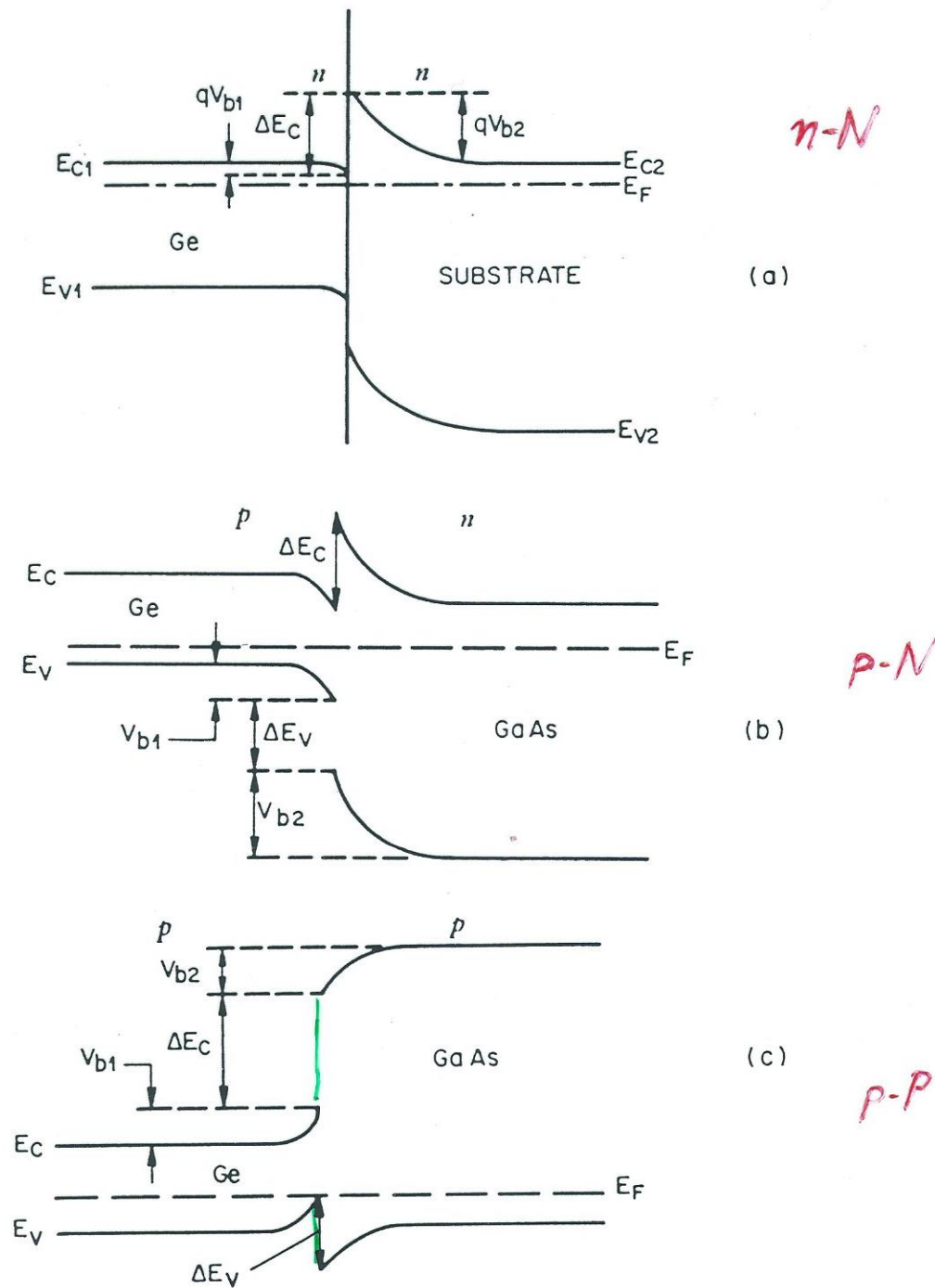


Fig. 45 (a) Energy-band diagram for an ideal  $n-n$  isotype heterojunction. (After Chang, Ref. 61.) (b) and (c) Energy-band diagrams for ideal  $p-n$  and  $p-p$  heterojunctions, respectively. (After Anderson, Ref. 60.)

Στην επαφή  $n-N$  του σχήματος οι ζώνες καίμονται ανάποδα από την επαφή  $n-P$ , αφού το  $\Phi_2 < \Phi_1$

Θα έχουμε επιπλέον ηλεκτρόνια στην περιοχή της επιφάνειας του ημιαγωγού 1. Δεδομένης της μεγάλης πυκνότητας καταστάσεων στην  $Z.A.$  η μεταβατική περιοχή θα εκτείνεται μιά μικρή απόσταση προς το εσωτερικό του ημιαγωγού 1 (μικρό  $E_g$ ), και η τάση θα εφαρμόζεται κυρίως πάνω στον ημιαγωγό 2.

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΕΠΑΦΗΣ n-N

Για τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ  $V_{b1}-V_1$  και  $V_{b2}-V_2$  πρέπει να υπολογισθεί το ηλεκτρικό πεδίο  $\mathcal{E}$  σε κάθε πλευρά της ετεροεπαφής και μετά να απαιτηθεί η συνέχεια της ηλεκτρικής μετατόπισης  $D = \epsilon \mathcal{E}$ , της κοίτης στην επαφή

Υποθέτουμε ότι η επιπλέον συγκέντρωση ηλεκτρονίων στην ημισφαίρι 1 ακολουθεί στατιστική Boltzmann υπολογίζεται

$$D_1 = \epsilon_1 \cdot \mathcal{E}_1(x_0) = \left\{ 2 \cdot \epsilon_1 \cdot q \cdot N_{D1} \cdot \left[ \frac{kT}{q} \left( \exp \frac{q(V_{b1}-V_1)}{kT} - 1 \right) - (V_{b1}-V_1) \right] \right\}^{1/2} \quad (11)$$

και για την π.Α. στην ημισφαίρι 2

$$D_2 = \epsilon_2 \cdot \mathcal{E}_2(x_0) = \left[ 2 \cdot \epsilon_2 \cdot q \cdot N_{D2} \cdot (V_{b2}-V_2) \right]^{1/2} \quad (12)$$

Η σχέση που προκύπτει εξισώνοντας τις (11) και (12) είναι περιήλοκη. Αν το εκθετικό στην (11) αναλυθεί σε σειρά Taylor προκύπτει η ανισότητα (Anderson, 1962)

$$V_{b1}-V_1 < \left[ \frac{2kT}{q} \frac{\epsilon_2 \cdot N_{D2}}{\epsilon_1 \cdot N_{D1}} (V_{b2}-V_2) \right]^{1/2} \quad (13)$$

Επομένως, το ηλεκτροστατικό δυναμικό θα "πέφτει" κυρίως στον υφιαχμό 2, εκτός εάν  $N_{D2} \gg N_{D1}$  (ή για μεγάλη ορθή πώληση).

## ΟΙ I-V ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟΕΠΑΦΩΝ

Γενικά όλοι οι τύποι των διόδων περιγράφονται με μία σχέση της μορφής

$$I = I_0 \cdot \left[ \exp\left(\frac{qV}{nKT}\right) - 1 \right] \quad (14)$$

όπου  $I_0$  το ρεύμα κόρου σε μεγάλη αναστροφή τάση,  $q$  το φορτίο ηλεκτρονίου,  $K$  η σταθερά Boltzmann και  $n$  ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (ideality factor).

Το  $n$  είναι εμπειρική παράμετρος και δείχνει την απόκλιση από την απλή θεωρητική περιγραφή σε λειτουργία ορθής πόλωσης ( $V > 0$ ). Παίρνει τιμές κοντά στο 1 σε καλώς κατασκευασμένες επαφές pn και επαφές Schottky. Απόκλιση από το 1 συνδέεται εκεί με ατέλειες του υλικού, κλπ.

Για τις ετεροεπαφές δεν μπορεί να υπάρχει μία γενική θεωρητική περιγραφή των I-V χαρακτηριστικών, που να ισχύει για οποιοδήποτε συνδυασμό τύπων αγωγιμότητας και συγκεντρώσεων και για όλες τις συνθήκες πόλωσης μίας επαφής.

Η εμπειρική σχέση (14) χρησιμοποιείται <sup>και</sup> για pn ετεροεπαφές, αλλά τα  $I_0$  και  $n$  είναι πολύ περισσότερο περίηλοκο να αναλυθούν ή προσδιορισθούν. Για παράδειγμα, η πολύ διαφορετικό της μονάδας μπορεί να σημαίνει ότι μόνο το κλάσμα  $\frac{V}{n}$  της εφαρμοζόμενης τάσης  $V$  επηρεάζει την κίνηση των φορέων (ρεύμα). Αυτό συμβαίνει όταν το ρεύμα ελέγχεται μόνο από την τάση που πέφτει σε μία πλευρά της ετεροεπαφής (στην Π.Α.).

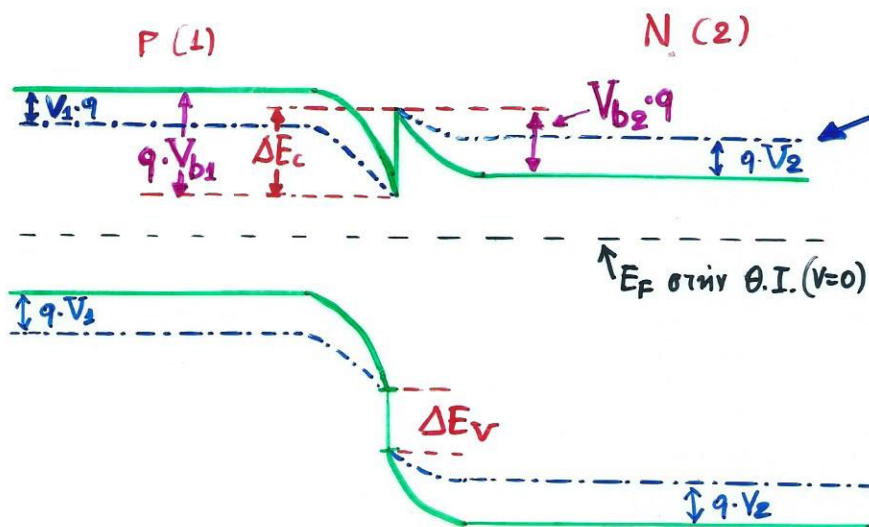
ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΧΥΕΙ ότι το ρεύμα στις ετεροεπαφές οφείλεται στην κίνηση, σχεδόν αποκλειστικά, ενός τύπου φορέα, αφού η συνήθως ανισότητα των ασυνεχειών  $\Delta E_c$ ,  $\Delta E_v$ , δά εμφανίζει διαφορετικά μεγέθη βραχμών ενέργειας γιαί κάθε τύπο φορέα

Το ρεύμα δά είναι (Anderson, 1962)

$$I = A \cdot \exp(-q\Phi_{B2}/kT) - B \exp(-q\Phi_{B1}/kT) \quad (15) \quad \text{Αρμιονική Εκπομπή}$$

όπου  $q\Phi_{B1}$  ο βραχμός δυναμικού γιαί ναί κινηθούν οι (επικρατέστεροι) φορείς από τον ημιαγωγό 1 στον 2 και  $q\Phi_{B2}$  το αντίστροφο. Οι συντελεστές  $A$  και  $B$  δά εξαρτώνται από τις συγκεντρώσεις προσμίξεων, τις ενεργές μάζες και το μηχανισμό ροής ρεύματος.

Περίπτωση p-n ετεροεπαφής τού κατωθι σχήματος



Μετατόπιση των ζωνών με την εφαρμογή ορθής πόλωσης  $V = V_1 + V_2$  ( $V_{PN} > 0$ )

Οι ζώνες δά μετατοπιστούν σε αντίθετη κατεύθυνση αποστάσης  $qV_1$  και  $qV_2$  οίν εφαρμοσθί αναστροφή πόλωση  $V = V_1 + V_2$  ( $V_{PN} < 0$ )

1) Εάν  $qV_{b2} > \Delta E_c$  τότε  $q\Phi_{B1} = 0$  (16) στην (15)

Αυτό δά εξακολουθεί ναί ισχύει γιαί <sup>(οποιαδήποτε)</sup> αναστροφή πόλωση και γιαί ορθή πόλωση μέχρι ναί γίνει  $q(V_{b1} - V_1) < \Delta E_c$ . Τότε δά ισχύουν:

$$\text{Το } q\phi_{B2} = q(V_{b1} + V_{b2}) - \Delta E_c - q(V_1 + V_2) \quad (17)$$

Για  $V=0$ , δηλ. συνδεδεμένη θ.Ι. δαί είναι  $I=0$

$$\stackrel{(15), (16)}{\Rightarrow} B = A \cdot \exp\left\{ \frac{[-q(V_{b1} + V_{b2}) + \Delta E_c]}{kT} \right\} = A \exp\left\{ \frac{[-qV_{bi} + \Delta E_c]}{kT} \right\} \quad (18)$$

Για  $V>0$  και  $q\phi_{B1}=0$  δαί είναι, με βάση τις (17), (18)

$$I = A \cdot \exp\left\{ \frac{[-qV_{bi} + \Delta E_c]}{kT} \right\} \cdot \left[ \exp\left( \frac{qV}{kT} \right) - 1 \right] \quad (19)$$

Η (19) δαί ισχύει και για  $V<0$  αφού  $q\phi_{B1}=0$

$$2) \text{ Όταν } q(V_{b2} - V_1) < \Delta E_c \text{ τότε } q\phi_{B1} = \Delta E_c - q(V_{b1} - V_1) \neq 0 \quad (20)$$

Το  $q\phi_{B1}$  δαί αυξάνει με την αρνητική πρόσημο ( $V_1$ ). Το ρεύμα στον δεξιό όρο της (15) δαί γίνεται ολόφρα πιο αφελερτικό.

$$\text{Τώρα όμως το } q\phi_{B2} = q(V_{b2} - V_2) \quad (21)$$

Το  $V_2$  δαί είναι ένα κλάσμα της συνολικής τάσης  $V$ , δηλαδή

$$V_2 = V/\eta \quad (22)$$

$$\text{τότε } I = A \cdot \exp\left(-\frac{qV_{b2}}{kT}\right) \cdot \exp\left(\frac{qV_2}{kT}\right) \quad (22) \Rightarrow$$

$$I = A \cdot \exp\left(-\frac{qV_{b2}}{kT}\right) \cdot \exp\left(\frac{qV}{\eta kT}\right) \quad (23)$$

Επομένως το ρεύμα δαί μεταβάλλεται εκθετικά με το  $V_2 = V/\eta$ . Θέλει προσοχή, επομένως, η απόκλιση του  $\eta$  από 1 στην γενική σχέση μιας δόδου ετεροελαφής να μίν συσχετισθεί με ακείδες, κέντρα ελανασύνδεσης-γένεσης, κτλ.



Ο συντελεστής  $A$  προηγείται, από τον Anderson, από τον ρυθμό διαίχουσας των φορέων. Στην  $n-p$  ετεροπαφή έχουμε διαίχουσι οπών στον υψιαγωγό μικρού κλάσματος και

$$A = \Psi \cdot \alpha \cdot q \cdot N_{A2} \left( \frac{D_p}{\tau_p} \right)^{1/2} \quad (24)$$

$\Psi$ : ένας συντελεστής διείδουσας, αντιπροσωπεύει το κλάσμα των οπών με ενέργεια μεγαλύτερη του φραγμού, ηω τελικά περνούν στην άλλη πλευρά

$D_p$ : σταθερά διαίχουσας των οπών στον υψιαγωγό μικρού  $E_g$

$\tau_p$ : χρόνος ζωής " " " " " " " "

$\alpha$ : η επιφάνεια της επαφής

Για τις επαφές  $n-N$  ή  $p-p$  εφόσον τα  $V_{b1}$  και  $V_1$  είναι μικρά ως προς  $V_{b2}$  και  $V_2$  και επειδή το ρεύμα αχεται από φορείς πλειονότητας, έχουμε (σύμφωνα με τον Anderson) περίπτωση ανάλογη με τη θερμοϊονική εκπομπή σε επαφές μετάλλου-υψιαγωγού, και

$$A = \Psi \cdot \alpha \cdot q \cdot N_2 \left( \frac{kT}{2\pi m^*} \right)^{1/2} \quad (25)$$

Στην περίπτωση της  $n-N$  επαφής ο  $\delta z_e$  έχει την πληρύτερη σχέση ρεύματος θερμοϊονικής εκπομπής (από L.L. Chang, 1965)

$$J = A^* T^2 \exp\left(-\frac{qV_{b2}}{kT}\right) \left[ \exp\left(\frac{qV_2}{kT}\right) - \exp\left(\frac{qV_1}{kT}\right) \right] \quad (26)$$

όπου  $A^*$  η ενεργός σταθερά Richardson

$$\text{Με την προέγγιση}^{(*)} \exp\left[\frac{q(V_{b1}-V_1)}{kT}\right] \approx \frac{q}{kT} (V_{b1}-V)$$

(\*) με υπόθεση  $\epsilon_1 N_{D1} \approx \epsilon_2 N_{D2}$   
 $V_{b1} \gg kT/q$

$$\Rightarrow J = J_0 \left(1 - \frac{V}{V_{b1}}\right) \left[ \exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right] \quad (27)$$

$$\text{με } J_0 = \frac{qA^* T \cdot V_{b1}}{k} \exp\left(-\frac{qV_{b1}}{kT}\right)$$

Το αναίστροφο ρεύμα θα αυξάνει γραμμικά με την τάση  $V$ . Σε ορθή πόλωση  $J \sim \exp(qV/kT)$ .